D4SBS6

60V 4A

特長

- 薄型 SIP パッケージ
- SBD ブリッジ
- 低 V_F

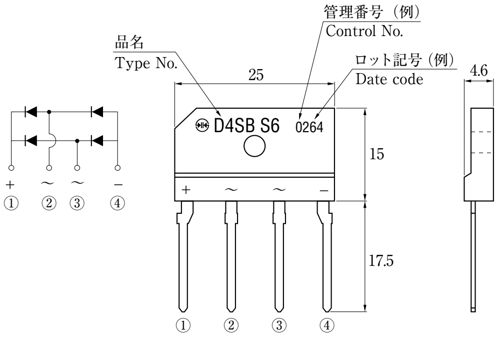
Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low V_F

■外観図 OUTLINE

Package：3S

Unit : mm
Weight : 3.9g（typ.）



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification “Marking, Terminal Connection.”

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 Tc＝25℃／unless otherwise specified）

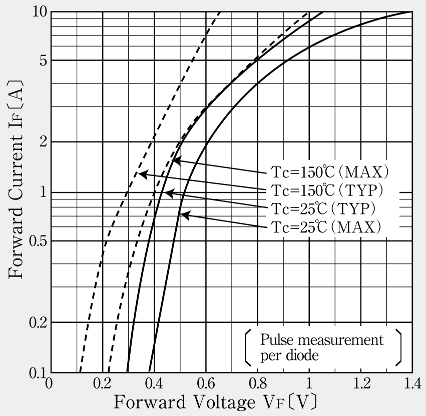
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBS6	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			−40～150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波，抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink Tc＝114℃	4	A
			フィンなし Without heatsink Ta＝46℃	2.3	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波，非繰り返し 1 サイクルせん頭値，Tj＝125℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj＝125℃		60	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P_{RRSM}	パルス幅10μs，1 素子当たり，Tj＝25℃ Pulse width 10μs, per diode, Tj＝25℃		330	W
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間，AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	（推奨値：0.5 N・m） （Recommended torque : 0.5 N・m）		0.8	N・m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合 Tc＝25℃／unless otherwise specified）

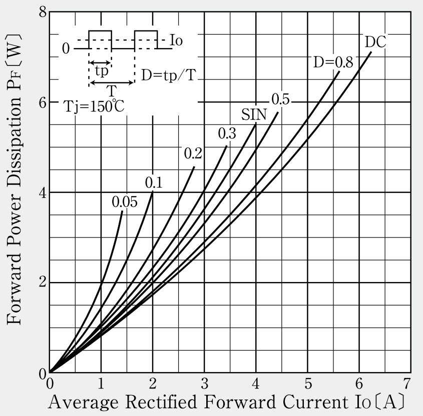
順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F＝2A，パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.62	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R＝V_{RM}，パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 2	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	f＝1MHz，V_R＝10V，1 素子当たりの規格値 per diode	TYP 180	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間，フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 5.5	℃/W
	θjl	接合部・リード間，フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6	
	θja	接合部・周囲間，フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 30	

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

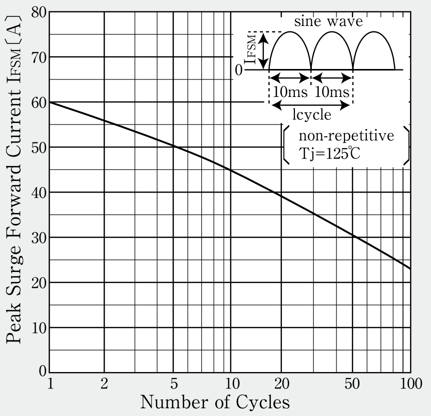
順方向特性
Forward Voltage



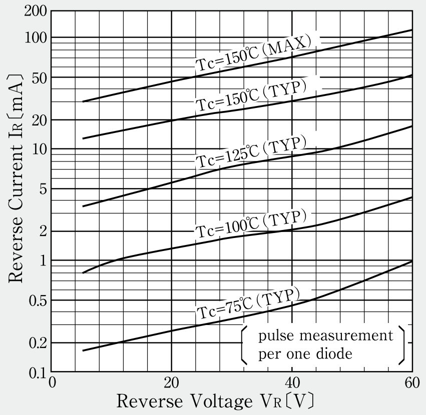
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



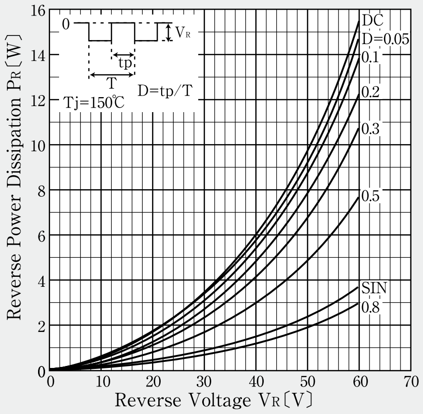
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



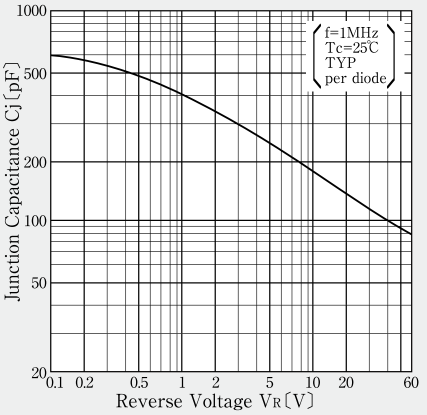
逆方向特性
Reverse Current



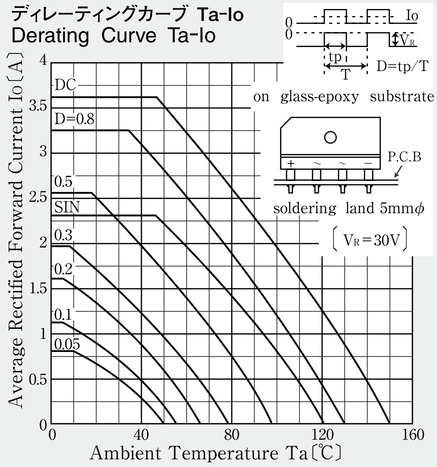
逆電力損失曲線
Reverse Power Dissipation



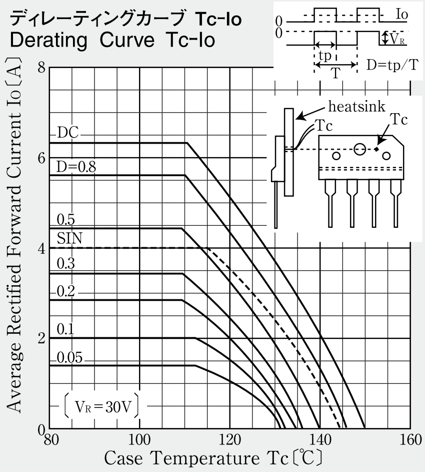
接合容量
Junction Capacitance



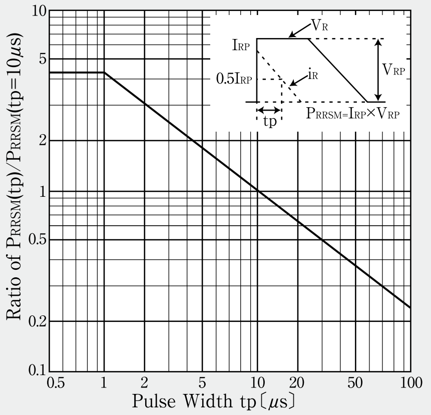
ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



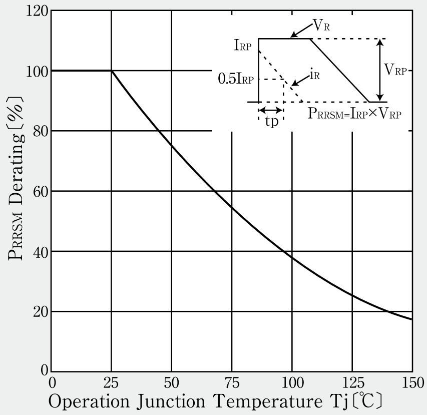
ディレーティングカーブ Tc-Io
Derating Curve Tc-Io



繰り返しせん頭サージ逆電流耐量
Repetitive Surge Reverse Power Capability



繰り返しせん頭サージ逆電力減少率
Repetitive Surge Reverse Power Derating Curve



＊ Sine wave は 50Hz で測定しています。
＊ 50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
＊ Semiconductor products generally have characterristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen:

D4SBS6-7100 D4SBS6-4100 D4SBS6-7000